



ES2A - ES2J

SMD супербыстрый диод

Диапазон напряжения : 50 - 600 В

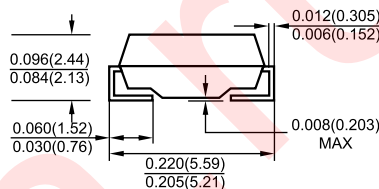
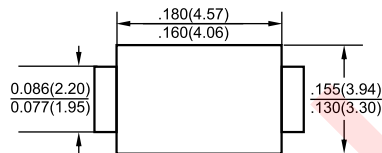
Ток: 2.0A

SMB/DO-214AA



Особенности

- ❖ Запассивированный стеклом переход.
- ❖ Для поверхностного монтажа.
- ❖ Низкопрофильный корпус.
- ❖ Идеально подходит для автоматического размещения.
- ❖ Легко выбрать место для монтажа.
- ❖ Ультра-быстрое время восстановления для высокой эффективности.
- ❖ Высокая температура пайки: 260°C/10 секунд на вывод.
- ❖ Пластиковые материалы UL классификация пажаробезопасности 94V-0



Механические данные

- ❖ Корпус: литой пластиковый корпус JEDEC DO-214AA.
- ❖ Вывода: луженная припоем латунь.
- ❖ Полярность: цветовая маркировка обозначает катод.
- ❖ Вес: 0.003 унций, 0.093 грамм

Размеры в дюймах (миллиметрах).

Максимальные технические и электрические характеристики.

Значения параметров при 25°C температуре окружающей среды, если не указано иное. Однофазный, напряжение (В) половина волны, частота – 50 Гц, для резистивных и индуктивных нагрузок. Для емкостной нагрузки уменьшайте ток на 20%.

		ES 2A	ES 2B	ES 2C	ES 2D	ES 2E	ES 2G	ES 2H	ES 2J	Един. измер.
Максимальное пиковое импульсное обратное напряжение	V _{RRM}	50	100	150	200	300	400	500	600	В
Максимальное среднеквадратическое значение напряжения	V _{RMS}	35	70	105	140	210	280	350	420	В
Максимальное постоянное запирающее напряжение	V _{DC}	50	100	150	200	300	400	500	600	В
Максимальный средний прямой выпрямленный ток @T _L = 90°C	I _(AV)	2.0								А
Максимальный прямой ток импульса в течении 8.3 мсек. одиночная полусинусоидальная волна, наложенная на номинальную нагрузку	I _{FSM}	50								А
Максимальное падение напряжения на открытом диоде при прямом токе 2.0 А	V _F	0.95				1.3		1.7		В
Максимальный постоянный обратный ток при номинальном пост. обратном напряжении @T _A =25°C @T _A =125°C	I _R					10 350				мкА
Максимальное время обратного восстановления (Прим. 1)	T _{rr}					35				нсек
Типичная емкость перехода (Прим. 2)	C _j	25				20				пФ
Максимальное тепловое сопротивление (Прим. 3)	R _{θJA} R _{θJL}					75 20				°C/Вт
Диапазон рабочих температур	T _J	-55 to +150								°C
Диапазон температур хранения	T _{STG}	-55 to +150								°C

Примечание: 1. Измерено с $I_F=0.5A$, $I_R=1A$, $I_{rr}=0.25A$.

2. Измеряется на частоте 1.0 МГц и обратном постоянном напряжении 4,0 В.

3. Установленный на медную площадку 0.4x0.4" (10x10 мм) печатной платы.

ES2A - ES2J

SMD супербыстрый диод

Рис.1 - График снижения выходного тока

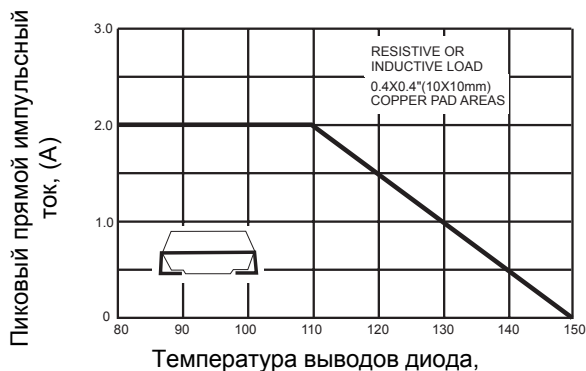


Рис.3 - Максимальный неповторяющийся пиковый ударный прямой ток

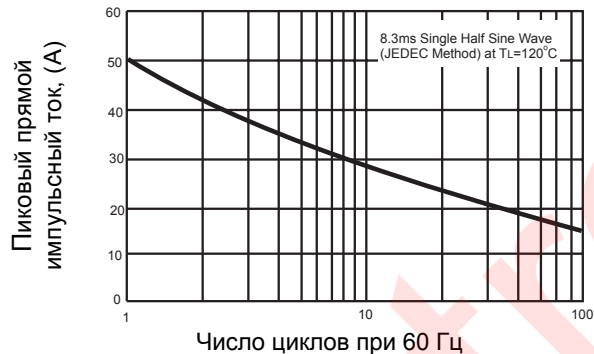


Рис.4 - Типичная емкость перехода

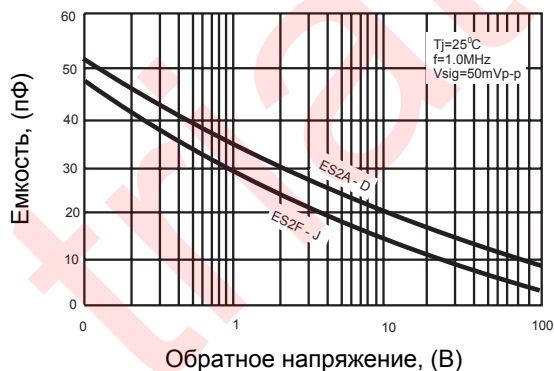


Рис.2 - Типичная обратная характеристика

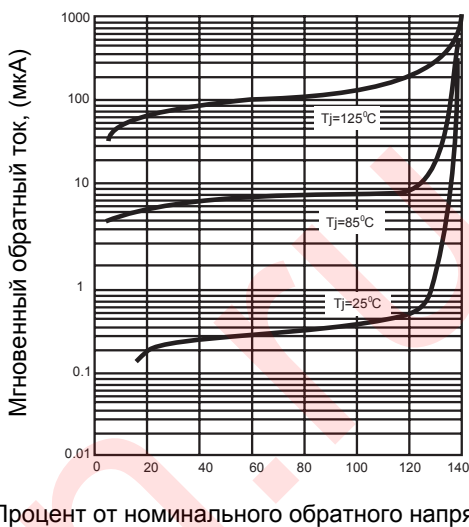


Рис.3 - Типичная прямая характеристика

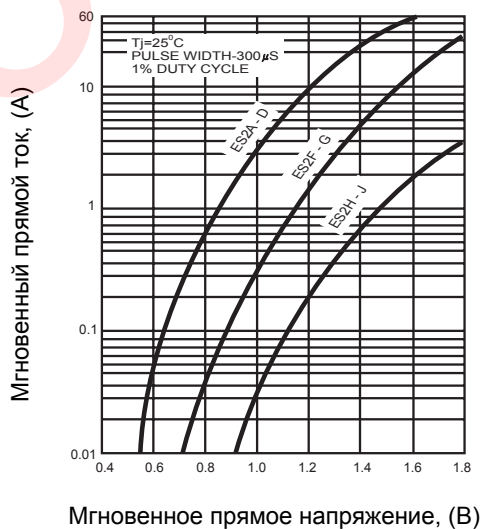
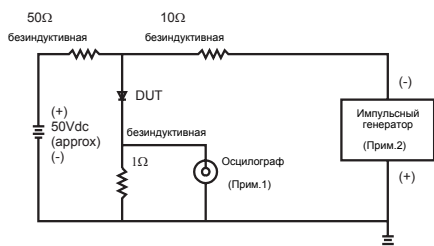


Рис.6 - Схема испытательной цепи для установления времени обратного восстановления



Примечания: 1. Время нарастания = 7нсек, макс. входное сопротивление = 1 Мом, 22пф.
2. Время нарастания = 10 нсек макс. сопротивление источника = 50 ом.